

Физика и техника полупроводников, 2018, том 52, выпуск 2

Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)

Яфаров Р.К.

Использование атомной структуры кристаллов кремния для получения многоострийных полевых источников электронов

147

Электронные свойства полупроводников

Калыгина В.М., Ремезова И.Л., Толбанов О.П.

Проводимость гетеропереходов Ga₂O₃-GaAs

154

Ормонт М.А., Звягин И.П.

Особенности частотной зависимости проводимости неупорядоченных полупроводников в области перехода к режиму с постоянной длиной прыжка

161

Мустафаева С.Н., Асадов С.М., Керимова Э.М.

Диэлектрические свойства и электропроводность легированного серебром монокристалла TlGaS₂

167

Кажукаускас В., Гарбачаускас Р., Савицки С.

Электрически активные состояния захвата и переноса заряда, обуславливающие медленную рекомбинацию в кристаллах бромида таллия при низких температурах

171

Соболев М.М., Солдатенков Ф.Ю.

Влияние глубоких уровней дислокаций в гетероэпитаксиальных InGaAs/GaAs и GaAsSb/GaAs p-i-n-структурах на время релаксации неравновесных носителей

177

Спектроскопия, взаимодействие с излучениями

Улашкевич Ю.В., Каминский В.В., Романова М.В., Шаренкова Н.В.

Исследование длинноволновых инфракрасных спектров отражения моно- и поликристаллов SmS в области гомогенности

184

Абдуллин Х.А., Гриценко Л.В., Кумеков С.Е., Мархабаева А.А., Теруков Е.И.

Влияние термических и плазменных обработок на фотолюминесценцию пленок оксида цинка

189

Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Лубянский Я.В., Бондарев А.Д., Сошников И.П., Берт Н.А., Золотарев В.В., Кириленко Д.А., Котляр К.П., Пихтин Н.А., Тарасов И.С.

Влияние концентрации кислорода в составе газовой плазмообразующей смеси на оптические и структурные свойства пленок нитрида алюминия

196

Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Сафонов Д.А., Виниченко А.Н., Каргин Н.И., Васильевский И.С.

Электронный транспорт в квантовых ямах AlGaAs/InGaAs/ GaAs PHEMT при различных температурах: влияние одностороннего дельта-легирования Si

201

Павлов Н.В., Зегря Г.Г., Зегря А.Г., Бугров В.Е.

Внутризонное поглощение излучения дырками в квантовых ямах InAsSb/AlSb и InGaAsP/InP

207

Аморфные, стеклообразные, органические полупроводники

Рыжов В.А., Мелех Б.Т.

Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Станчик А.В., Гременок В.Ф., Башкиров С.А., Тиванов М.С., Юшкенас Р.Л., Новиков Г.Ф., Герайтис Р., Саад А.М.

Микроструктура и комбинационное рассеяние света тонких пленок $\text{Cu}_2\text{ZnSnSe}_4$, осажденных на гибкие металлические подложки

Ратников В.В., Щеглов М.П., Бер Б.Я., Казанцев Д.Ю., Осинных И.В., Малин Т.В., Журавлев К.С.

Изменение характера биаксиальных напряжений при возрастании x от 0 до 0.7 в слоях $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}:\text{Si}$, полученных методом аммиачной молекулярно-лучевой эпитаксии

Углеродные системы

Давыдов С.Ю.

Расширенная модель Холстейна-Хаббарда для эпитаксиального графена на металле

Мирошников Б.Н., Мирошникова И.Н., Попов А.И.

Оптимизация параметров поликристаллических фоторезисторов на основе PbS

Физика полупроводниковых приборов

Солован М.Н., Андрущак Г.О., Мостовой А.И., Ковалюк Т.Т., Брус В.В., Марьянчук П.Д.

Диоды Шоттки графит/ p -SiC, полученные методом переноса нарисованной пленки графита на SiC

Тягинов С.Э., Макаров А.А., Jech M., Векслер М.И., Franco J., Kaczer B., Grasser T.

Физические основы самосогласованного моделирования процессов генерации интерфейсных состояний и транспорта горячих носителей в транзисторах на базе структур металл-диэлектрик-кремний

Зубов Ф.И., Максимов М.В., Гордеев Н.Ю., Полубавкина Ю.С., Жуков А.Е.

Подавление волноводной рекомбинации за счет использования парных асимметричных барьеров в лазерных гетероструктурах

Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур

Пещерова С.М., Якимов Е.Б., Непомнящих А.И., Павлова Л.А., Феклисова О.В., Пресняков Р.В.

Электрическая активность протяженных дефектов в мультикремнии

Лотин А.А., Новодворский О.А., Паршина Л.С., Храмова О.Д., Черобыло Е.А., Михалевский В.А.

Люминесцентные свойства тонких пленок $\text{Cd}_x\text{Zn}_{1-x}\text{O}$

Шиманский А.Ф., Павлюк Т.О., Копыткова С.А., Филатов Р.А., Городищева А.Н.

Влияние добавок кремния на свойства монокристаллов германия для инфракрасной оптики

Тысченко И.Е., Кривякин Г.К., Володин В.А.

Ионный синтез кристаллической фазы Ge в пленках SiO_xN_y при отжиге под высоким давлением

Персоналии

Захарий Фишелевич Красильник (к 70-летию со дня рождения)